



NSG2113 700V 4A 半桥式功率 MOSFET/IGBT 驱动芯片

1 产品特性

- 自举工作的浮动通道
 - 最高工作电压可达 700 V
 - 兼容 3.3V、5V 和 15V 输入逻辑
 - dV_s/dt 耐受能力可达 ± 50 V/nsec
 - V_s 负偏压能力达 -9V
 - 栅极驱动电范围 10 V-20V
 - 宽温度范围 -40~125°C
 - 集成欠压锁定功能
 - 周期性边缘触发关断逻辑
 - 输入输出同相位
 - 逻辑和电源地 $\pm 5V$ 偏移
 - 芯片开通关断延时特性
 - $T_{on}/T_{off} = 130ns/130ns$
 - 高低侧延时匹配
 - 驱动电流能力：
 - 拉电流/灌电流 = 4.0A/4.0A
 - 高、低侧欠压锁定电路
 - 欠压锁定正向阈值 8.9V
 - 欠压锁定负向阈值 8.2V
 - 符合 RoSH 标准
- SOIC16 (W)

2 应用范围

- 通用逆变器
- 交流和直流电源中的半桥和全桥转换器
- 用于服务器、电信、IT 和工业基础设施的高密度开关电源
- 太阳能逆变器、电机驱动器和 UPS

3 产品概述

NSG2113 是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片，采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动电路可以单芯片集成。具有独立的高、低侧传输通道 NSG2113 的逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平，输出具有大电流脉冲能力，其浮动通道可用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET，浮地通道最高工作电压可达 700V。NSG2113 内部集成高低侧 shutdown 逻辑，可用于故障条件下的通断关断。NSG2113 采用宽体 SOIC16 (W) 封装，可以在 -40°C 至 125°C 温度范围内工作。

器件信息

零件号	封装	封装尺寸 (标称值)
NSG2113	SOIC16(W)	10.3mm x 7.5mm

简化示意图

